## ФИЗИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА

УДК 537.621; 537.622

# ЭФФЕКТ ХОЛЛА В ФРУСТРИРОВАННЫХ ФЕРРИМАГНИТНЫХ СПЛАВАХ $\varepsilon'$ -Мп $_3$ Ga

#### В. Н. Прудников, М. В. Прудникова

#### (кафедра магнетизма)

Проведены исследования электрического сопротивления, поперечного магнетосопротивления и эффекта Холла сплавов  $\varepsilon'$ -Mn<sub>3</sub> Ga в состоянии фрустрированного ферримагнетизма. Для парамагнитного состояния коэффициент нормального эффекта Холла  $R_0$  имеет величину  $\sim 10^{-13}$  Ом·см·Гс<sup>-1</sup>, типичную для металлов. Магнитное упорядочение вызывает значительное изменение  $R_0$  и инверсию его знака. Коэффициент аномального эффекта Холла изменяет знак одновременно с  $R_0$  и функционально не связан с электрическим сопротивлением. Величина и знак эффекта Холла определяются наличием двух подсистем, одна из которых связана с областями ближнего магнитного порядка, другая — с фрустрированными спинами на границах этих областей.

#### Введение

В состоянии фрустрированного ферримагнетизма магнетик представляет собой неоднородную систему, в которой имеет место сильное рассеяние носителей тока. Длина свободного пробега носителей становится величиной порядка межатомных расстояний. При таких условиях кинетические параметры оказываются чрезвычайно чувствительными к ближнему магнитному порядку. Поэтому исследование эффекта Холла и магнетосопротивления позволяет проследить кинетику разрушения дальнего магнитного порядка при возвратных переходах.

Экспериментальные данные по аномальному эффекту Холла (АЭХ) в таких материалах обычно интерпретируют в рамках следующих моделей: асимметричного рассеяния [1], бокового смещения [2] или «спиновой компоненты» [3]. Пик на температурной зависимости холловского сопротивления, аналогичный пику на температурной зависимости низкополевой восприимчивости, обычно связывают с асимметричной компонентой АЭХ, возникающей из-за резонансного рассеяния электронов проводимости на виртуальном связанном *d*-уровне, который локализован на примесном атоме.

В фрустрированных магнитных системах, отличающихся типом магнитного порядка, степенью фрустраций, состоянием электронной системы, имеет место большое разнообразие особенностей в поведении кинетических коэффициентов [4]. Однако можно указать и некоторые общие черты, типичные для фрустрированных магнетиков. Так, в парамагнитном состоянии или в состоянии спинового стекла, которые практически одинаково сильно разупорядочены, коэффициенты нормального эффекта Холла (НЭХ) и АЭХ должны иметь практически одинаковую величину [4]. Изменения в величине коэффициентов Холла происходят лишь при появлении спиновых корреляций, которые приводят к изменению механизмов рассеяния носителей тока и изменению электронного спектра.

#### 1. Методика эксперимента

Сплавы Mn–Ga, на которых проведены измерения холловского сопротивления  $\rho_h$ , поперечного магнетосопротивления  $\Delta \rho_{\perp}/\rho$ , электрического сопротивления  $\rho$ , были приготовлены в ЦНИИЧермет им. И.П.Бардина. Для выплавки использовались спектрально чистые материалы: марганец с чистотой 99,999% и галлий марки ГЛ000. Полученная в процессе плавки отливка в виде прутка подвергалась гомогенизирующему отжигу в течение 6–10 ч с последующей закалкой. Из сплава  $\gamma$ -Mn<sub>3</sub>Ga путем отжига в течение 8 ч при температуре ~450°С получалась частично упорядоченная  $\varepsilon'$ -фаза Mn<sub>3</sub>Ga со сверхструктурой, упорядоченной по типу DO<sub>22</sub>.

В качестве объекта исследования был выбран сплав Mn<sub>0.75</sub> Ga<sub>0.25</sub>, который в неупорядоченном состоянии имеет ГЦК-структуру, подобную модификации у-Mn [3]. Замещение атомов марганца диамагнитными атомами галлия разрушает связи Mn-Mn и создает в системе спинов фрустрированные обменные взаимодействия. При указанных концентрациях Mn и Ga создаются оптимальные условия фрустраций. В исследованном сплаве Mn<sub>3</sub> Ga стехиометрического состава возможно атомное разупорядочение [5, 6]. Это позволяет на одном и том же образце исследовать магнитные и кинетические свойства структурных состояний с различной степенью атомного и магнитного порядка: ферримагнитного ( $\varepsilon'$ -Mn<sub>3</sub>Ga) и антиферромагнитного ( $\gamma$ -Mn<sub>3</sub>Ga) типа [7]. Исследования магнитных свойств сплава  $\varepsilon'$ -Mn<sub>3</sub>Ga показали, что эта фаза находится в ферримагнитном неэргодичном состоянии, в котором при нагревании происходит двойной переход «ферримагнитное спиновое стекло — ферримагнетизм — парамагнетизм» (ФиМСС-ФиМ-ПМ) [8].

Электрическое сопротивление, магнетосопротивление, эффект Холла были изучены при температурах 20–730°С в магнитных полях до 18 кЭ. Измерения

проводились при постоянном токе с использованием четырехконтактной методики.

#### 2. Экспериментальные результаты и обсуждение

На рис. 1, 2 представлены зависимости удельного холловского сопротивления  $\rho_h$  и поперечного магнетосопротивления  $\Delta \rho_{\perp}/\rho$  от величины магнитного поля при 20°С. Полевая зависимость холловского сопротивления состоит из двух линейных участков с различным наклоном (излом при  $H \approx 10$  кЭ). Тангенс угла наклона высокополевого (при H > 10 кЭ) участка кривой  $\rho_h(H)$  больше, чем низкополевого, что противоположно результатам для намагниченности [8]. При повышении температуры излом наблюдается при меньших значениях магнитного поля, при этом тангенс угла наклона кривой  $\rho_h(H)$  возрастает. Линейность участков сохраняется до 350°С. По мере дальнейшего роста температуры в высоких магнитных полях появляется тенденция к насыщению  $\rho_h(H)$ . Резкое изменение поперечного магнетосопротивления отмечается в магнитных полях, при которых меняется наклон прямых  $\rho_h(H)$ .

Нагревание до T < 400 °C с последующим охлаждением в отсутствие магнитного поля не сказывается на зависимости  $\rho_h(H)$ , как это видно из рис. 1, где разными точками обозначены значения  $\rho_h$ , полученные после охлаждения от различных температур до комнатной. В то же время даже небольшие различия в термомагнитной обработке на стадии отжига чрезвычайно сильно влияют на кинетические свойства  $\varepsilon'$ -Mn<sub>3</sub>Ga.



Рис. 1. Зависимость удельного холловского сопротивления  $\rho_h$  сплава  $\varepsilon'$ -Мп<sub>3</sub>Ga от магнитного поля при T = 20 °C: исходное состояние (•), после охлаждения от T = 118 °C (□), 287 °C (△) и 395 °C (○)



Рис. 2. Зависимость поперечного магнетосопротивления  $\Delta \rho_{\perp} / \rho$  сплава  $\varepsilon'$ -Mn<sub>3</sub> Ga от магнитного поля H при 20°C



*Рис.* 3. Зависимость удельного холловского сопротивления  $\rho_h$  сплава  $\varepsilon'$  -Mn<sub>3</sub> Ga от магнитного поля при некоторых температурах

Семейство температурных зависимостей холловского сопротивления в магнитных полях до 18 кЭ представлено на рис. 3. Сравнение  $\rho_h(T)$  с температурной зависимостью намагниченности [7] свидетельствует о их корреляции и подтверждает наличие АЭХ в изученных сплавах. Температура  $T_c$ , при которой наблюдается максимум  $\rho_h$ , совпадает с температурой, соответствующей максимуму намагниченности, и, следовательно, может служить основой для определения температуры Кюри из измерений кинетических параметров. Увеличение магнитного поля, при котором проводятся измерения, сдвигает температуру  $T_c$  в область более низких температур.

Сравнение температурных зависимостей холловского сопротивления и намагниченности для сплава  $\varepsilon'$ -Мп<sub>3</sub> Ga показывает, что резкое изменение в их поведении наблюдается при одинаковых температурах, причем для зависимостей  $\rho_h(T)$  это проявляется значительно четче. В связи с этим зависимость  $\rho_h(T)$ может быть использована для более точного определения температуры перехода в состояние ферримагнитного спинового стекла  $(T_g(H))$ . Значения  $T_g$  и  $T_c$ отмечены на рис. 4, где представлены температурные зависимости удельного холловского сопротивления при некоторых значениях магнитного поля. Каждая кривая  $\rho_h(T)$  состоит из трех участков. В пределах первого участка зависимость  $\rho_h(T)$  линейна. Линейная зависимость нарушается при температурах  $T_{q}(H)$ , значения которых в существенной степени зависят от магнитного поля (см. рис. 4). В пределах



Рис. 4. Зависимость удельного холловского сопротивления  $\rho_h$  сплава  $\varepsilon'$ -Mn<sub>3</sub> Ga от температуры в различных магнитных полях

второго участка ( $T_g < T < T_c$ ) холловское сопротивление всегда возрастает при увеличении температуры, что характерно для ферримагнитного состояния (ФиМ). На третьем участке  $\rho_h(T)$  резко уменьшается при увеличении температуры во всех магнитных полях.

Для выделения вкладов НЭХ и АЭХ измерения холловского сопротивления и намагниченности были проведены на одних и тех же образцах при одинаковой геометрии эксперимента. В температурной области существования неэргодичной фазы ФиМСС (ферримагнитное спиновое стекло) при  $T < T_g$  наблюдается линейная зависимость приведенного холловского сопротивления  $\rho_h/H$  от магнитной восприимчивости  $\chi$ , что может свидетельствовать о независимости от температуры и магнитного поля коэффициентов  $R_0$  и  $R_a$  (рис. 5). Их значения составляют:  $R_0 = -11.4 \cdot 10^{\perp 11}$  Ом  $\cdot$  см  $\cdot$  Гс<sup> $\perp 1$ </sup>.

На рис. 5 показаны зависимости  $R_0$  и  $R_a$  от температуры в ферримагнитном состоянии сплава. Следует иметь в виду, что в области температур  $0 \div 500$  °C в магнитном поле  $H \approx 6$  кЭ зависимость холловского сопротивления  $\rho_h(T)$  отклоняется от линейной и определение  $R_0$  и  $R_a$  таким способом не совсем корректно. Значения коэффициентов Холла, приведенные на рис. 5, характеризуют общую тенденцию их изменения при переходе ФиМСС–ФиМ.

Таким образом, коэффициент аномального эффекта Холла  $R_a$  в  $\varepsilon'$ -фазе сплава Mn<sub>3</sub> Ga и в  $\gamma$ -фазе [6] имеет один порядок величины и один знак ( $R_a > 0$ ), тогда как коэффициент нормального эффекта Холла  $R_0$  в состоянии ФиМСС на три порядка больше, чем



Рис. 5. Зависимость от температуры коэффициентов  $R_a$  (АЭХ) и  $R_0$  (НЭХ) сплава  $\varepsilon'$ -Мп<sub>3</sub> Ga. Отмечено значение температуры перехода ( $T_g = 325$  °С при H = 0) из состояния ферримагнитного спинового стекла (ФиМСС) в ферримагнитное состояние (ФиМ)

в состоянии антиферромагнитного спинового стекла [6]. Последнее указывает на значительные изменения зонной структуры сплава  $Mn_3$  Ga при переходе  $\gamma \rightarrow \varepsilon'$ .

Учитывая конфигурацию атома Mn  $(3d^54s^1)$  и атома Ga  $(3d^{10}4s^24p^1)$  при определении эффективного числа носителей тока, можно утверждать, что величина нормального эффекта Холла определяется в первую очередь системой 4s-, 4p- и 3d-электронов. Это подтверждается результатами исследований сплава  $\gamma$ -Mn<sub>3</sub>Ga в парамагнитном состоянии [9], согласно которым эффективный магнитный момент атома Mn составляет  $\mu = 2\mu_B$ , т.е. из всех d-подобных электронных состояний локализованы только два электрона в атоме Mn. Это подтверждается и расчетами электронной структуры для чистого  $\gamma$ -Mn в приближении когерентного потенциала [10]. Таким образом, в исходном  $\gamma$ -Mn<sub>3</sub>Ga электроны атома Mn неэквивалентны и отличаются подвижностью.

Так как сплав  $\varepsilon'$ -Mn<sub>3</sub>Ga не может быть получен в парамагнитном состоянии (выше  $T_c$  происходит структурный переход  $\varepsilon' \to \varepsilon$ ), то сравниваются только состояния ФиМ и ФиМСС. Оценки показывают, что в отличие от  $\gamma$ -Mn<sub>3</sub>Ga в  $\varepsilon$ -Mn<sub>3</sub>Ga в состоянии ФиМ коллективизированы все пять 3d-электронов атома Mn, причем оно обладает дырочной проводимостью. В состоянии ФиМСС лишь часть атомов Mn имеет пять коллективизированных d-электронов. В другой части атомов, по-видимому принадлежащей фрустрированной подсистеме, коллективизированы только три d-электронов это приводит к эффекту компенсации вкладов от положительных и отрицательных носителей тока и большому отрицательному значению  $R_0$ . Заметим, что коэффициент АЭХ определяется исключительно 3d-электронами атомов Мп и эффект компенсации на нем не сказывается.

Таким образом, эффект Холла и электрическое сопротивление определяются вкладами от двух магнитных подсистем, одна из которых связана с областями ближнего магнитного порядка, другая — с фрустрированными спинами на границах этих областей.

#### Литература

- 1. McAlister S.P., Hurd C.M. // J. Phys. F. 1978. 8. P. 239.
- 2. Hurd C.M., McAlister S.P. // J. Appl. Phys. 1979. 59. P. 1743.
- Anderson J.E.A., Hurd C.M. // J. Phys. Chem. Solids. 1971. 32. P. 2075.
- Ведяев А.В., Грановский А.Б., Каминская Е.П., Котельникова О.А. // Письма в ЖЭТФ. 1979. 30. С. 685.
- 5. Гоманьков В.И., Равдель М.П., Ногин И.Н. и др. // ФММ. 1979. 47. С. 735.
- Prudnikov V., Silonov V., Prudnikova M., Rodin S. // J. Magn. Magn. Mater. 1998. 188. P. 393.
- Прудников В.Н. // Вестн. Моск. ун-та. Физ. Астрон. 1999.
  № 5. С. 34 (Moscow University Phys. Bull. 1999. No. 5).
- Hori T., Morii Y., Funahashi S. et al. // Physica B. 1995. 213/214. P. 354.
- 9. Козлова Т.М., Прудников В.Н., Хакамов М.Ф., Шитова Е.А. Препринт физ. ф-та МГУ. 1986, № 12.
- 10. Fletcher G.C. // J. Phys. F. 1971. 1. P. 177.

Поступила в редакцию 04.09.98

УДК 535.37; 621.315.592

## ТУННЕЛЬНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ СВЕРХРЕШЕТОК С КОНТРОЛИРУЕМЫМ БЕСПОРЯДКОМ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

## А. В. Дмитриев, О. В. Пупышева

### (кафедра физики низких температур)

Теоретически исследован вертикальный электронный транспорт в полупроводниковых сверхрешетках с контролируемым беспорядком в электрическом поле. Численно рассчитаны коэффициенты туннельного прохождения электронов через тонкослойные сверхрешетки с различными типами беспорядка в конечном поле.

#### Введение

Со времени создания слоистых твердотельных структур и сверхрешеток в 1970-х годах они непрерывно совершенствовались и стали часто использоваться как модельные системы для реализации и исследования одномерных задач квантовой механики. В частности, полупроводниковая сверхрешетка практически идеально представляет одномерную модель кристалла Кронига–Пенни [1]. Крайне интересно рассмотреть типичную квантовомеханическую задачу о подбарьерном туннелировании, в том числе резонансном, в применении к таким гетероструктурам [2, 3]. Возник интерес и к изучению свойств более сложных систем: гетероструктур с переменной шириной ям [4] и так называемых сверхрешеток Фибоначчи [5], в которых последовательность чередования слоев из разных материалов задается определенным правилом и которые не являются уже простыми периодическими объектами, оставаясь тем не менее детерминированными. В последнее время были выращены и сверхрешетки, в которых параметры слоев задаются последовательностью случайных чисел [6]. Эти новые и весьма интересные структуры можно назвать сверхрешетками с контролируемым беспорядком, так как последний намеренно вводится в них в процессе роста. В определенном смысле такие